

東芝電界効果トランジスタ シリコンPチャネルMOS形 (L²-π-MOSV)

2SJ509

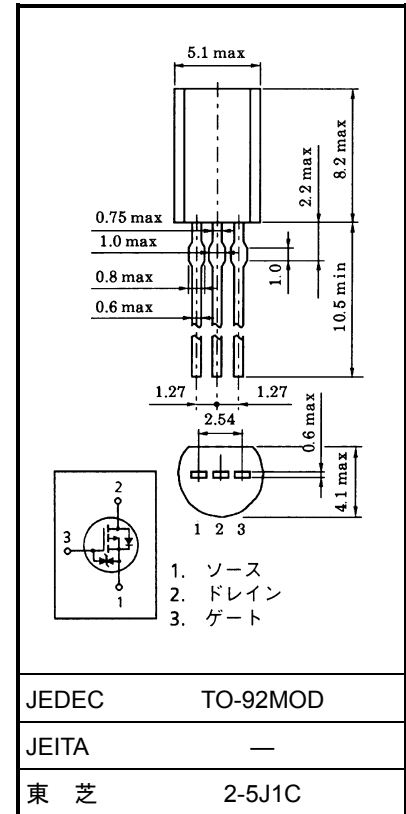
○ リレー駆動、DC-DCコンバータ用

単位: mm

- 4V 駆動品です。
- オン抵抗が低い。 : $R_{DS(ON)} = 1.35\Omega$ (標準)
- 順方向伝達アドミタンスが高い。 : $|Y_{fs}| = 0.7S$ (標準)
- 漏れ電流が低い。 : $I_{DSS} = -100\mu A$ (最大) ($V_{DS} = -100V$)
- 取り扱いが簡単な、エンハンスメントタイプです。
: $V_{th} = -0.8 \sim -2.0V$
($V_{DS} = -10V$, $I_D = -1mA$)

最大定格 (Ta = 25°C)

項目	記号	定格	単位
ドレイン・ソース間電圧	V_{DSS}	-100	V
ドレイン・ゲート間電圧 ($R_{GS} = 20k\Omega$)	V_{DGR}	-100	V
ゲート・ソース間電圧	V_{GSS}	± 20	V
ドレイン電流	DC (注1)	I_D	-1 A
	パルス (注1)	I_{DP}	-3 A
許容損失	P_D	0.9	W
アバランシェエネルギー (単発) (注2)	E_{AS}	136.5	mJ
アバランシェ電流	I_{AR}	-1	A
アバランシェエネルギー (連続) (注3)	E_{AR}	0.09	mJ
チャネル温度	T_{ch}	150	°C
保存温度	T_{stg}	-55 ~ 150	°C



質量: 0.36 g (標準)

熱抵抗特性

項目	記号	最大	単位
チャネル・外気間熱抵抗	$R_{th(ch-a)}$	138	°C/W

注1: チャネル温度が 150°C を超えることのない放熱条件でご使用ください。

注2: アバランシェエネルギー (単発) 印加条件
 $V_{DD} = -50V$, $T_{ch} = 25°C$ (初期)、 $L = 168mH$, $R_G = 25\Omega$, $I_{AR} = -1A$

注3: 連続印加の際、パルス幅は製品のチャネル温度によって制限されます。

この製品は MOS 構造です。取り扱いの際には、静電気にご注意ください。

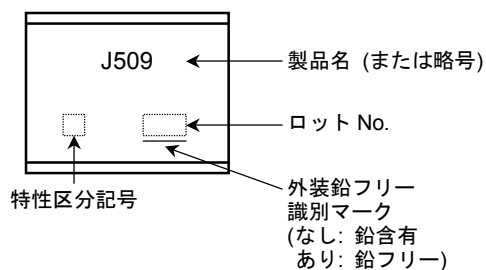
電気的特性 (Ta = 25°C)

項目	記号	測定条件	最小	標準	最大	単位	
ゲート漏れ電流	I _{GSS}	V _{GS} = ±16 V, V _{DS} = 0 V	—	—	±10	μA	
ドレインシャ断電流	I _{DSS}	V _{DS} = -100 V, V _{GS} = 0 V	—	—	-100	μA	
ドレイン・ソース間降伏電圧	V(BR) _{DSS}	I _D = -10 mA, V _{GS} = 0 V	-100	—	—	V	
ゲートしきい値電圧	V _{th}	V _{DS} = -10 V, I _D = -1 mA	-0.8	—	-2.0	V	
ドレイン・ソース間オン抵抗	R _{DS(ON)}	V _{GS} = -4 V, I _D = -0.5 A	—	1.68	2.5	Ω	
		V _{GS} = -10 V, I _D = -0.5 A	—	1.34	1.9		
順方向伝達アドミタンス	Y _{fs}	V _{DS} = -10 V, I _D = -0.5 A	0.3	0.7	—	S	
入力容量	C _{iss}	V _{DS} = -10 V, V _{GS} = 0 V, f = 1 MHz	—	135	—	pF	
帰還容量	C _{rss}		—	22	—		
出力容量	C _{oss}		—	48	—		
スイッチング時間	上昇時間	t _r		—	20	—	ns
	ターンオン時間	t _{on}		—	32	—	
	下降時間	t _f		—	25	—	
	ターンオフ時間	t _{off}		Duty ≤ 1%, t _w = 10 μs	—	130	
ゲート入力電荷量	Q _g	V _{DD} ≐ -80 V, V _{GS} = -10 V, I _D = -1 A	—	6.3	—	nC	
ゲート・ソース間電荷量	Q _{gs}		—	4.1	—		
ゲート・ドレイン間電荷量	Q _{gd}		—	2.2	—		

ソース・ドレイン間の定格と電気的特性 (Ta = 25°C)

項目	記号	測定条件	最小	標準	最大	単位
ドレイン逆電流(連続)(注1)	I _{DR}	—	—	—	-1	A
ドレイン逆電流(パルス)(注1)	I _{DRP}	—	—	—	-3	A
順方向電圧(ダイオード)	V _{DSF}	I _{DR} = -1 A, V _{GS} = 0 V	—	—	1.5	V
逆回復時間	t _{rr}	I _{DR} = -1 A, V _{GS} = 0 V dI _{DR} / dt = 50 A / μs	—	90	—	ns
逆回復電荷量	Q _{rr}		—	180	—	nC

現品表示



当社半導体製品取り扱い上のお願い

030519TAA

- 当社は品質、信頼性の向上に努めておりますが、一般に半導体製品は誤作動したり故障することがあります。当社半導体製品をご使用いただく場合は、半導体製品の誤作動や故障により、生命・身体・財産が侵害されることのないように、購入者側の責任において、機器の安全設計を行うことをお願いします。
なお、設計に際しては、最新の製品仕様をご確認の上、製品保証範囲内でご使用いただくと共に、考慮されるべき注意事項や条件について「東芝半導体製品の取り扱い上のご注意とお願い」、「半導体信頼性ハンドブック」などをご確認ください。
- 本資料に掲載されている製品は、一般的電子機器（コンピュータ、パーソナル機器、事務機器、計測機器、産業用ロボット、家電機器など）に使用されることを意図しています。特別に高い品質・信頼性が要求され、その故障や誤作動が直接人命を脅かしたり人体に危害を及ぼす恐れのある機器（原子力制御機器、航空宇宙機器、輸送機器、交通信号機器、燃焼制御、医療機器、各種安全装置など）にこれらの製品を使用すること（以下“特定用途”という）は意図もされていませんし、また保証もされていません。本資料に掲載されている製品を当該特定用途に使用することは、お客様の責任でなされることとなります。
- 本資料に掲載されている技術情報は、製品の代表的動作・応用を説明するためのもので、その使用に際して当社および第三者の知的財産権その他の権利に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。
- 本資料に掲載されている製品を、国内外の法令、規則および命令により製造、販売を禁止されている応用製品に使用することはできません。
- 本資料の掲載内容は、技術の進歩などにより予告なしに変更されることがあります。